

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0402U000122

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-01-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Клименко Ігор Андрійович

2. Klymenko Igor Andriiovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.02.

Назва наукової спеціальності:

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 19-12-2001

Спеціальність за освітою: 23.03

Місце роботи здобувача: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: Україна, 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.169.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут монокристалів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код за ЄДРПОУ: 02066769

Місцезнаходження: Україна, 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:

1. Дослідження макроскопічних ростових дефектів кристалів ZnSe і CdZnTe
2. Investigation of macroscopic growth defects of ZnSe and CdZnTe crystals

Реферат:

1. Об'єкт дослідження - кристали ZnSe і CdZnTe, а також детектори та оптичні елементи на їх основі. Мета дослідження - розробка методики виявлення та функціональної ідентифікації макроскопічних ростових дефектів кристалів ZnSe і CdZnTe. Методи дослідження та апаратура: Оптичні та діелектричні методи. Сучасні прилади та нестандартне обладнання. Теоретичні та практичні результати, новітність: Встановлено, що інформативними про характер внутрішніх полів є низькочастотні діелектричні параметри. Представлення діелектричних відгуків у вигляді графічних образів дозволило визначити характеристичні ознаки макроскопічних ростових дефектів та ідентифікувати їх як витоки чи стоки внутрішнього електричного поля. Показано можливість використання методики функціональної ідентифікації макроскопічних дефектів для контролю технологічної обробки кристалів, а також розроблено новий спосіб акустичної обробки кристалів ZnSe і CdZnTe. Ступінь упровадження: методика використовується на Державному підприємстві Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (м. Харків). Галузь

використання - напівпровідникове приладобудування.

2. The object of study - ZnSe and CdZnTe crystals, and also detectors and optical elements on it base. The aim of study - the development of a procedure of detection and functional identification of macroscopic growth defects of ZnSe and CdZnTe crystals. Methods and equipment: Optical and dielectrical methods. Modern instruments and non-standard equipment. Theoretical and practical results, newness: It is determined, that the low-frequency dielectric parameters are informative about character of internal fields. The representation of dielectric responses on test actions by the way of pictorial fashions has allowed to determine characteristic features of macroscopic growth defects aggregates and to identify them as sources and drains of internal fields. The possibility of using of macroscopic defects functional identification procedure for the monitoring of a technological processing is shown and the new method of acoustic processing of ZnSe and CdZnTe crystals is designed. Degree of practical application: the procedure is used in National enterprise Research technological institute of instrument-making (Kharkov). Field of application - semiconductor instrument-making.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мигаль В.П.

2. Мигаль В.П.

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Литвинов Л.А.
2. Литвинов Л.А.

Кваліфікація: д.т.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Балицький О.І.
2. Балицький О.І.

Кваліфікація: д.т.н., 05.02.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Толмачов О.В.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Толмачов О.В.

